





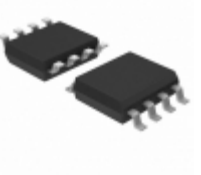



	<p><b>SI9926CDY-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI9926CDY-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI9926CDY-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 24028 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9926CDY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24028 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 8.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI9926CDY-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI9926CDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9926CDY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9926CDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI9926CDY</b> SI SI9926CDY SI</p>	 <p><b>SI9926DY-T1-E3</b> VISHAY SI9926DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI9926BE</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p><b>SI9926CDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI9926CDY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9926C</b> KEXIN SI9926C KEXIN</p>	 <p><b>SI9926DY-T1</b> SILICON SI9926DY-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI9926CDY-T1-E3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- |                    |                     |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊗ SI9711CY         | ↔ SI9711CY-T1-E3    | ↔ SI9712DY         | D SI9712DY-T1      | ↔ SI9712DY-T1-E3   |
| ⊣ SI9712DY-T1-E3   | ⊗ SI9712DY-T1       | D SI9717CY         | ↔ SI9731DQ-T1      | ↔ SI9731DQ-T1-E3   |
| ⊗ SI9731DQ-T1-E3   | ⊣ SI9925DY          | ⊗ SI9925DY-T1      | ↔ SI9925DY-T1-E3   | ↔ SI9926-3         |
| D SI9926ADY        | ⊗ SI9926ADY-T1      | ⊣ SI9926ADY-T1-E3  | ⊗ SI9926ADY-T1-GE3 | ↔ SI9926BDY-T1-E3  |
| ↔ SI9926BDY-T1-E3  | ↔ SI9926BDY-T1-GE3  | ⊗ SI9926BDY-T1-GE3 | ⊣ SI9926CDY        | ↔ SI9926CDY-T1-E3  |
| ↔ SI9926CDY-T1-GE3 | ↔ SI9926CDY-T1-GE3  | D SI9926DY         | ⊗ SI9926DY-T1      | ⊣ SI9926DY-T1-E3   |
| ⊗ SI9926DY-T1-GE3  | D SI9928DY-T1       | ↔ SI9928DY-T1-E3   | ↔ SI9933ADY-T1     | ↔ SI9933ADY-T1-E3  |
| ⊣ SI9933ADY-T1-E3  | ⊗ SI9933ADY-T1-E3.. | ↔ SI9933BDY        | ↔ SI9933BDY-T1-E3  | ↔ SI9933BDY-T1-E3  |
| ⊗ SI9933BDY-T1-E3  | ⊣ SI9933CDY         | ⊗ SI9933CDY-T1-E3  | D SI9933CDY-T1-E3  | ↔ SI9933CDY-T1-GE3 |
| ↔ SI9933CDY-T1-GE3 | ⊗ SI9933DY-D1-E3    | ⊣ SI9933DY-T1      | ⊗ SI9933DY-T1-E3   | ↔ SI9933DY-T1-E3   |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited